

ST-302は、縦型透明樹脂でモールドされた高感度のシリコンフォトトランジスタです。薄型、小型で実装が容易です。

The ST-302 is a high-sensitivity NPN silicon phototransistor mounted in a clear low profile side-viewing package. This phototransistor is both compact and easy to mount.

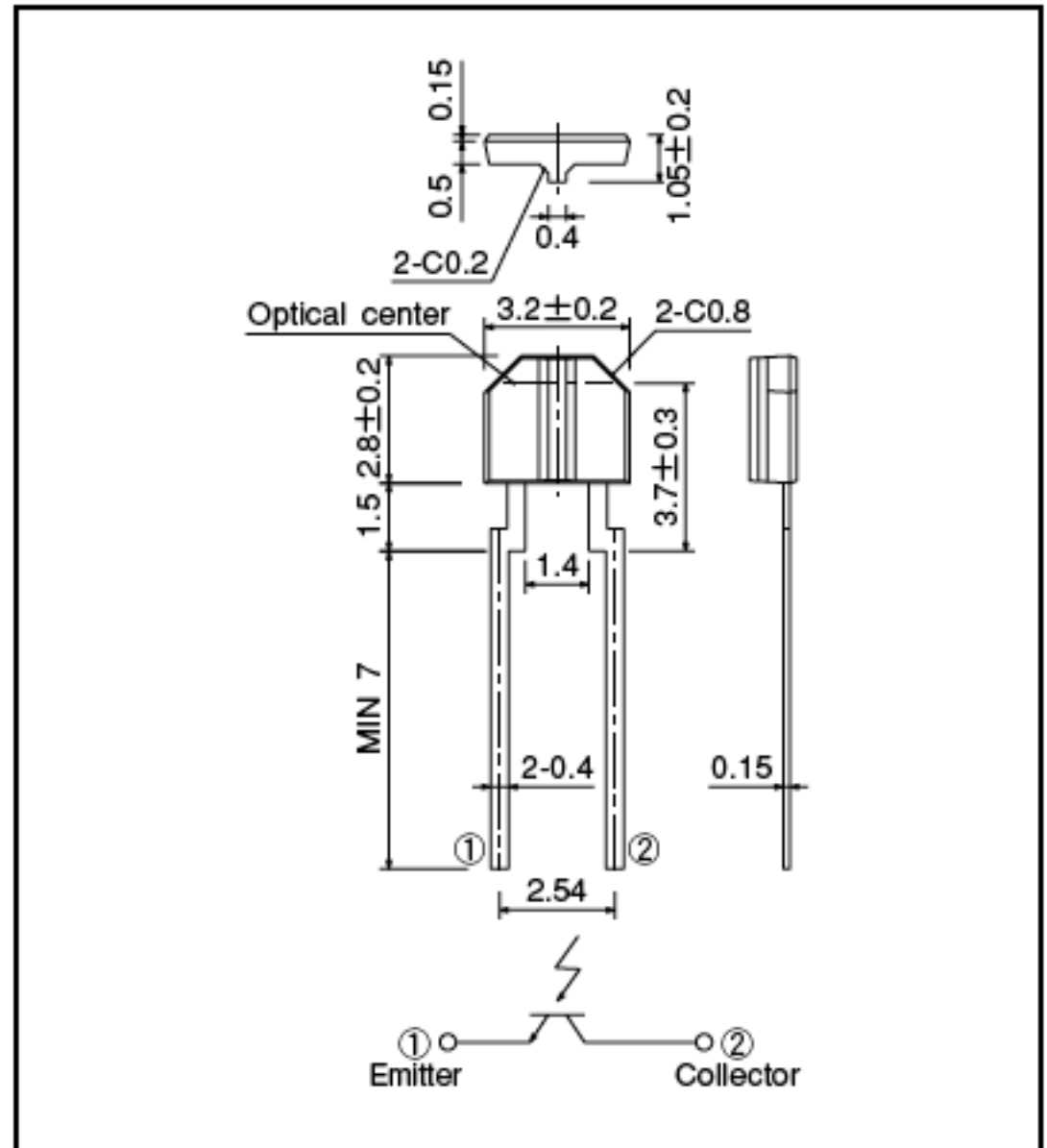
■特長 FEATURES

- 樹脂モールドタイプ
- 超薄型
- Side-viewing plastic package
- Low profile package

■用途 APPLICATIONS

- フォトインタラプタ
- Photointerrupters

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 C-E voltage	V _{CEO}	30	V
エミッタ・コレクタ間電圧 E-C voltage	V _{ECO}	5	V
コレクタ電流 Collector current	I _C	20	mA
コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	75	mW
動作温度 Operating temp.	T _{opr.}	-25~+85	°C
保存温度 Storage temp.	T _{stg.}	-30~+100	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	T _{sol.}	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒
For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電氣的・光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

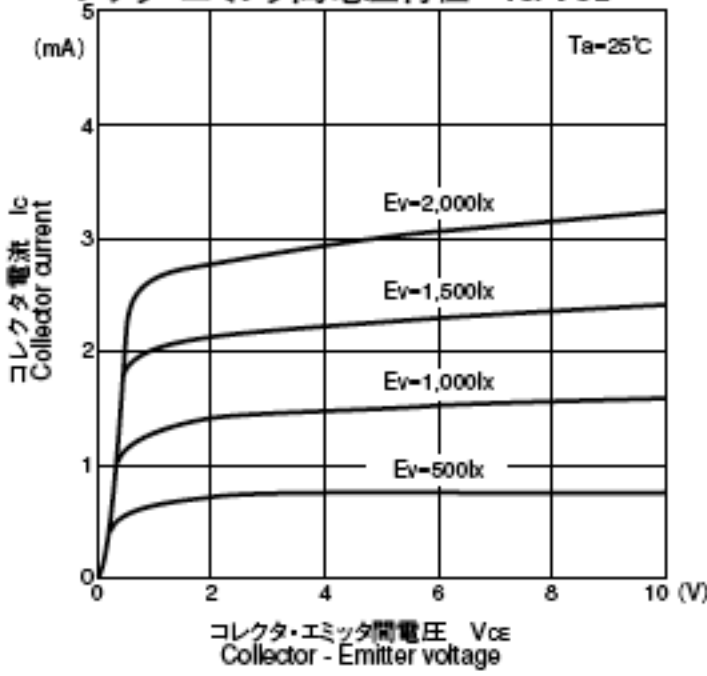
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
暗電流 Collector dark current	I _{CEO}	V _{CEO} =10V			0.1	μA
光電流 Light current	I _L	V _{CE} =5V, E _v =1000Lx ^{*2}	0.2	1.5		mA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _C =0.2mA, E _v =2000Lx ^{*2}		0.2	0.4	V
応答時間 Switching speeds	立上り時間 Rise time	V _{CC} =10V I _C =1mA R _L =100Ω		3.2		μsec.
	立下り時間 Fall time			4.8		μsec.
分光感度 Spectral sensitivity	λ		500~1050			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ _p			880		nm
半値角 Half angle	Δθ			±30		deg.

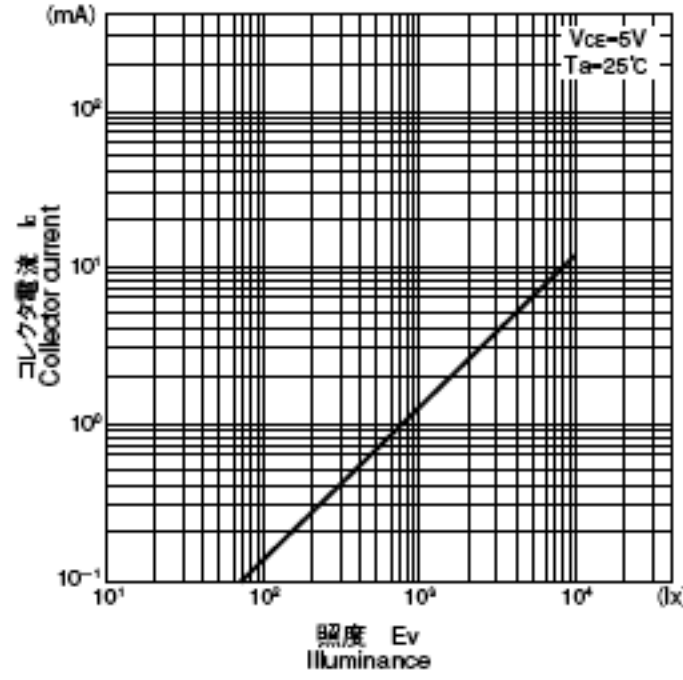
*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用に際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

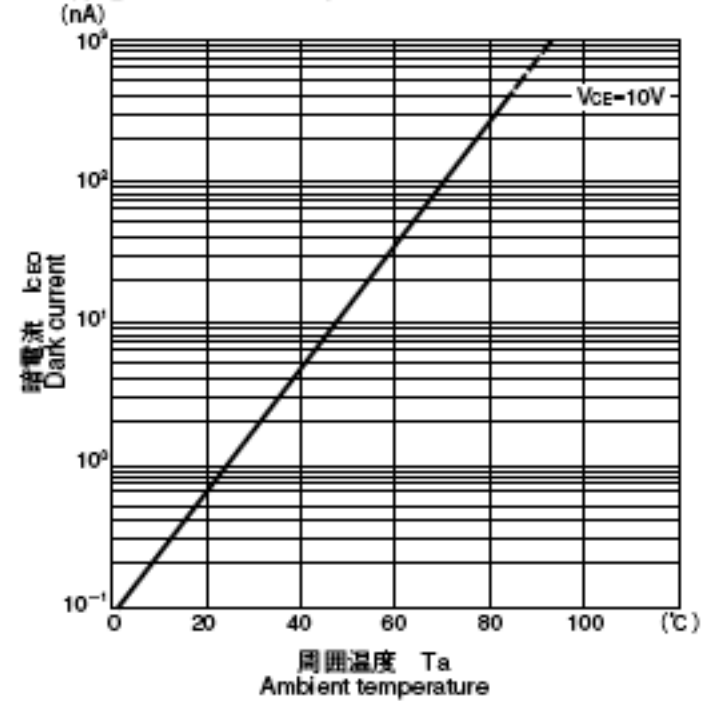
■コレクタ電流/
コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_C/V_{CE}



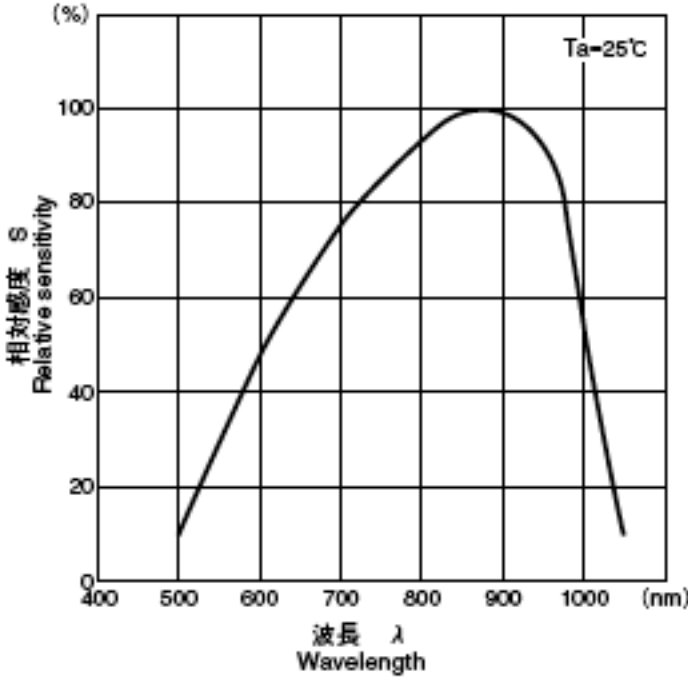
■コレクタ電流/照度特性 I_C/E_v



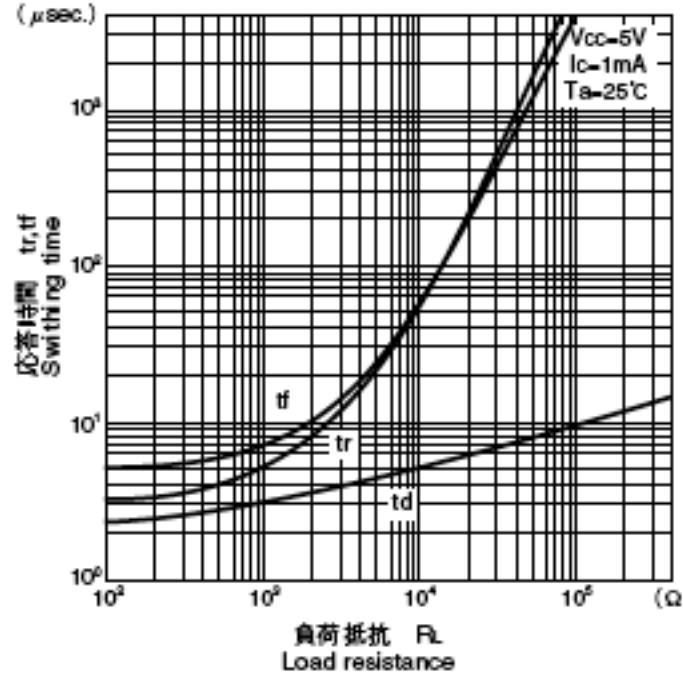
■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a



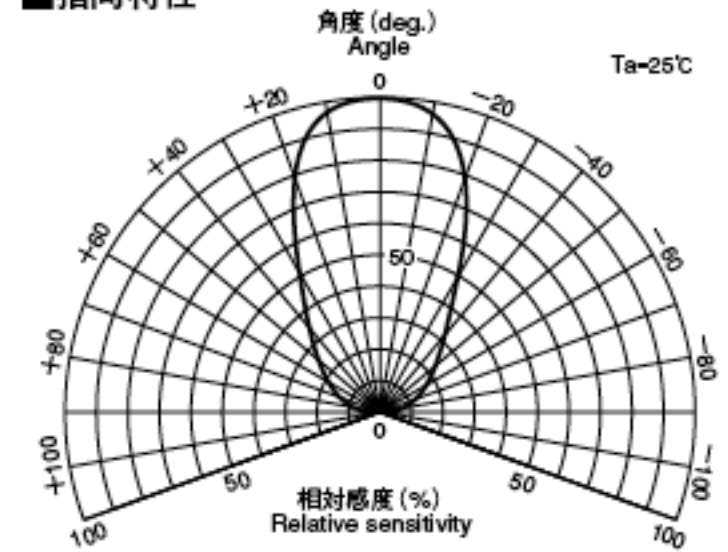
■分光感度特性



■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1



■指向特性



■許容コレクタ損失/周囲温度 P_C/T_a

